

RTE13K6M

シリコン N チャンネル MOS 型電界効果トランジスタ
ツェナーダイオード
複合トランジスタ

概要

RTE13K6M は、INK0012AX シリーズ相当のシリコン N チャンネル MOS 形電界効果トランジスタと、ツェナー電圧 8.2V のツェナーダイオードを内蔵した、複合トランジスタです。

このトランジスタのご使用により、セットの小型化、部品及び工数の大幅な削減が可能となります。

特長

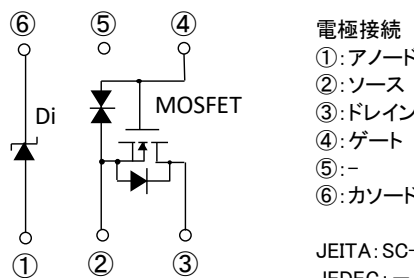
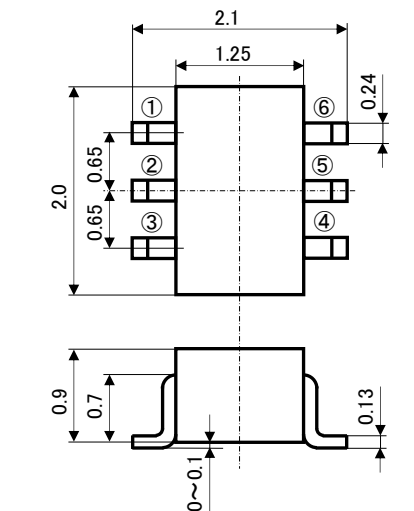
- スーパーミニパッケージ(6ピン)に INK0012AX シリーズ相当のシリコン N チャンネル MOS 形電界効果トランジスタと $V_z=8.2V$ ($\pm 5\%$) のツェナーダイオードを搭載。
- セットの小型化、高密度実装が可能

用途

電源回路、ドライバー回路等

外形図

単位:mm

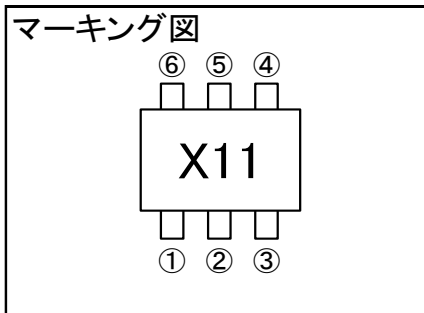


電極接続
①: アノード
②: ソース
③: ドレイン
④: ゲート
⑤: -
⑥: カソード

JEITA: SC-88
JEDEC: -

最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

記号	項目	定格値	単位
V_{DSS}	ドレイン・ソース間電圧	30	V
V_{GSS}	ゲート・ソース間電圧	± 20	V
I_D	ドレイン電流(DC)	200	mA
I_{DP}	ドレイン電流(パルス)	400	mA
P_D	全許容損失	150	mW
T_{ch}	接合部温度	+150	$^\circ C$
T_{stg}	保存温度	-55 ~ +150	$^\circ C$



※1: $P_w \leq 10\mu s$, Duty cycle $\leq 1\%$

RTE13K6M

シリコン N チャンネル MOS 型電界効果トランジスタ
ツェナーダイオード
複合トランジスタ

電気的特性(Ta=25°C)

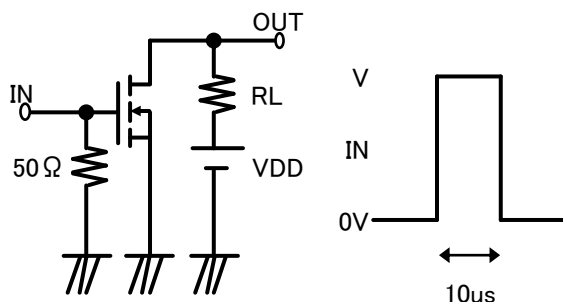
【MOSFET】

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
V(BR)DSS	ドレイン・ソース降伏電圧	Id=100μA, Vgs=0V	30	-	-	V
IGSS	ゲート漏れ電流	Vgs=±15V, Vds=0V	-	-	±1.0	μA
IDSS	ドレイン遮断電流	Vds=30V, Vgs=0V	-	-	1.0	μA
Vth	ゲート閾値電圧	Id=250μA, Vds=Vgs	1.0	-	2.0	V
Yfs	順方向伝達アドミタンス	Vds=10V, Id=100mA	-	245	-	mS
RDS(ON)	ドレイン・ソース間オン抵抗	Id=100mA, Vgs=4.0V	-	1.7	-	Ω
		Id=100mA, Vgs=10.0V	-	1.0	-	
Ciss	入力容量	Vds=10V, Vgs=0V, f=1MHz	-	23	-	pF
Coss	出力容量		-	7.0	-	
ton	スイッチング時間	VDD=5V, Id=10mA	-	30	-	ns
toff		Vgs=0~5V	-	66	-	

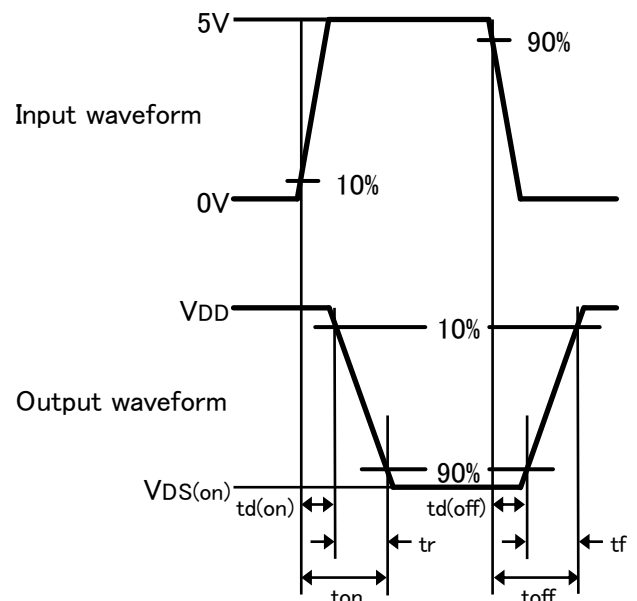
【Di】

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
VBR	降伏電圧	IR=5mA	7.8	8.2	8.6	V
IR	逆電流	VR=6.5V	-	-	1.0	μA
Ct	端子間容量	VR=0V	-	57	-	pF

Switching time test condition



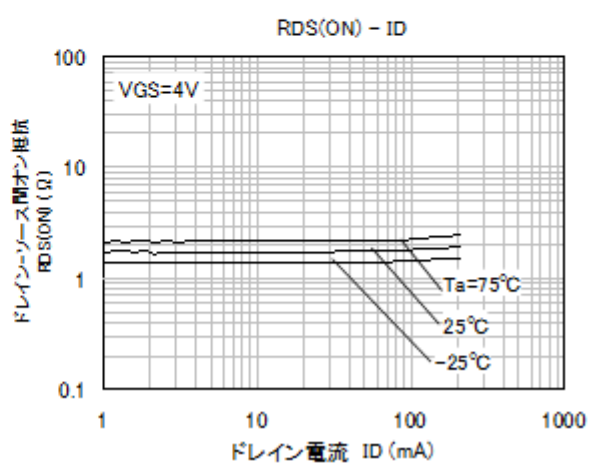
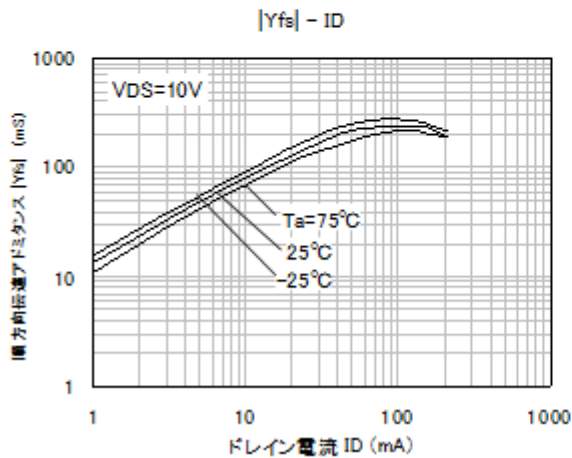
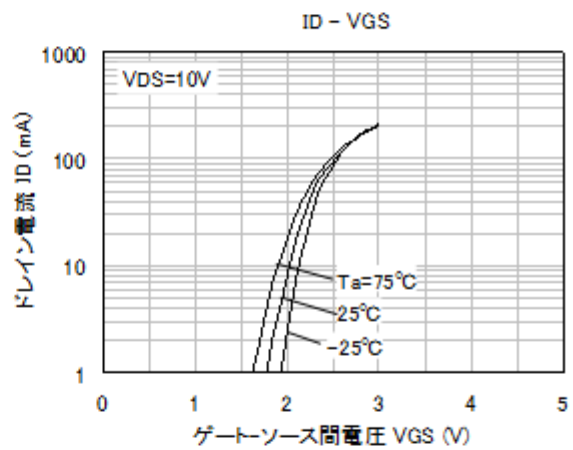
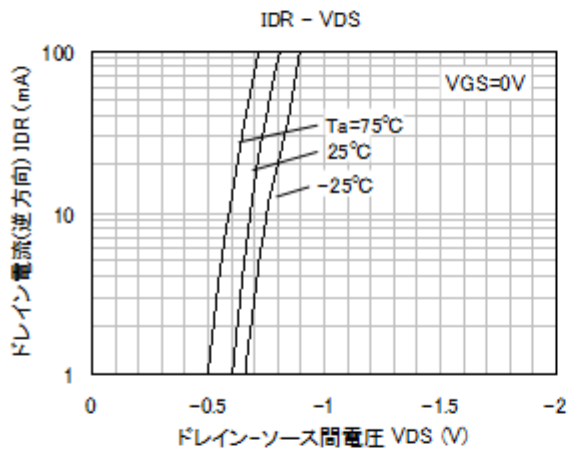
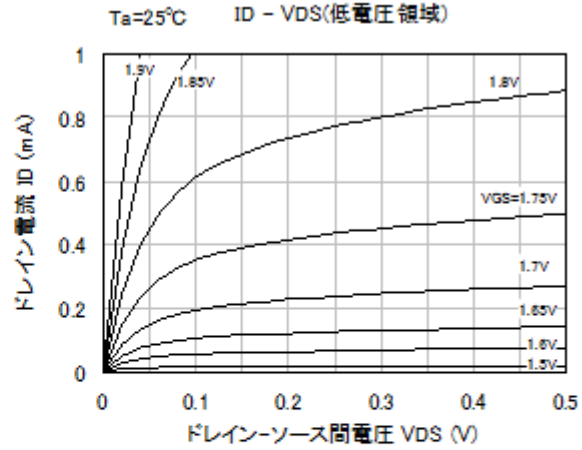
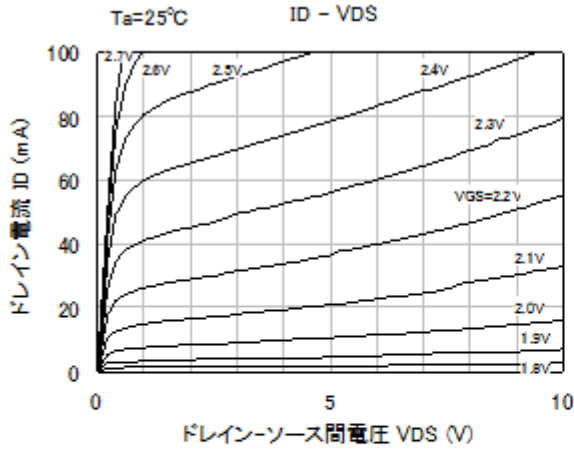
Duty ≤ 1%
Input: tr, tf < 10ns
VDD = 5V
Common source
Ta = 25°C



RTE13K6M

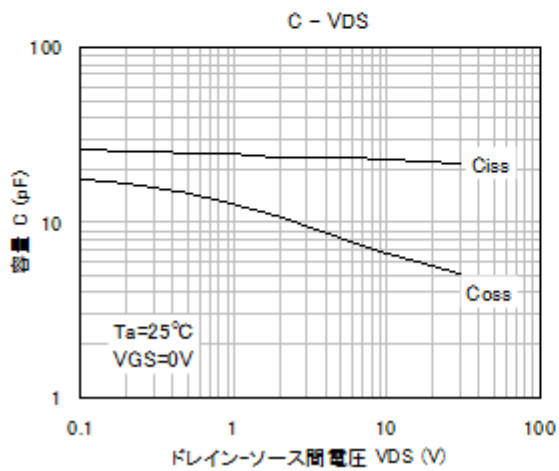
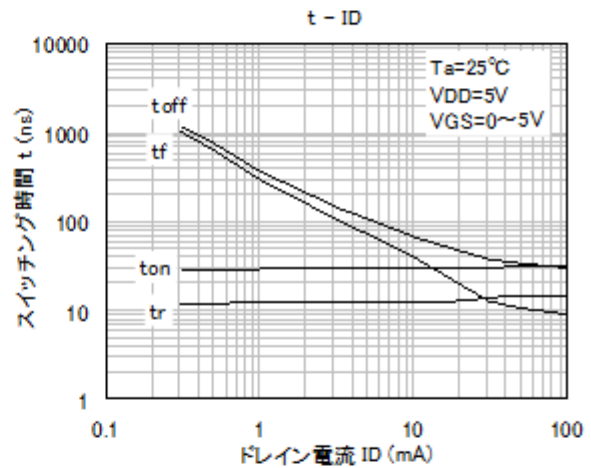
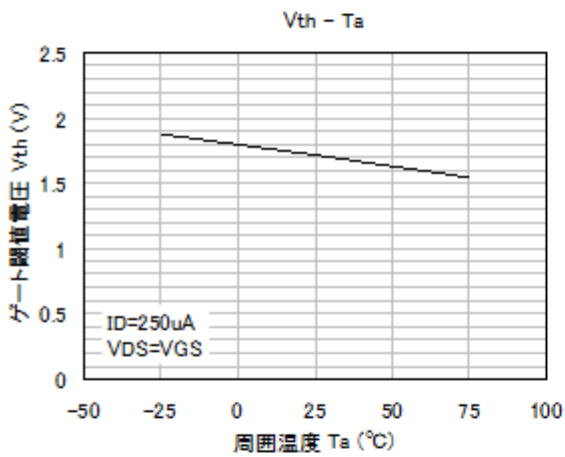
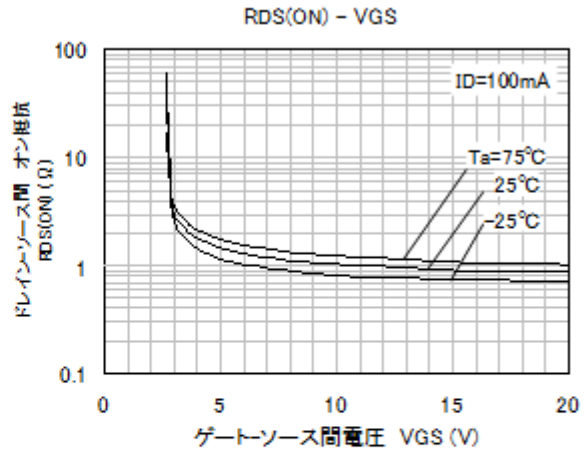
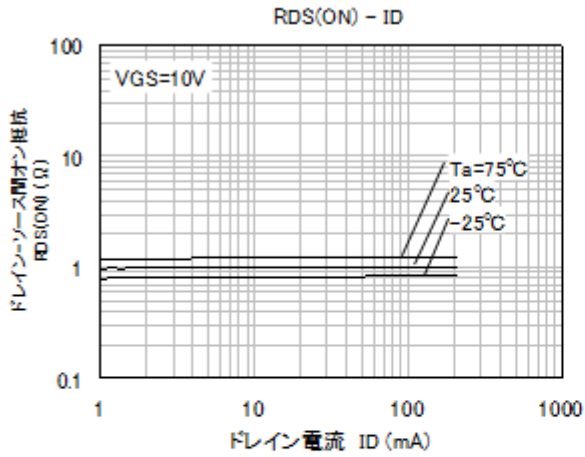
シリコン N チャンネル MOS 型電界効果トランジスタ
ツェナーダイオード
複合トランジスタ

標準特性(MOSFET)



RTE13K6M

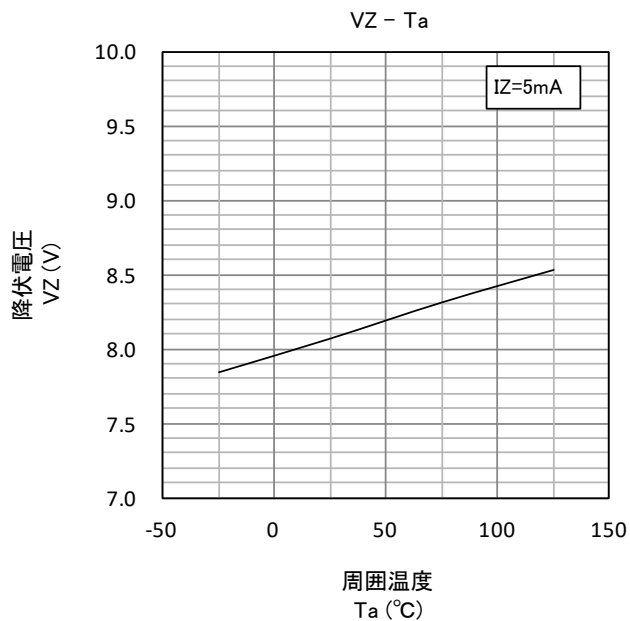
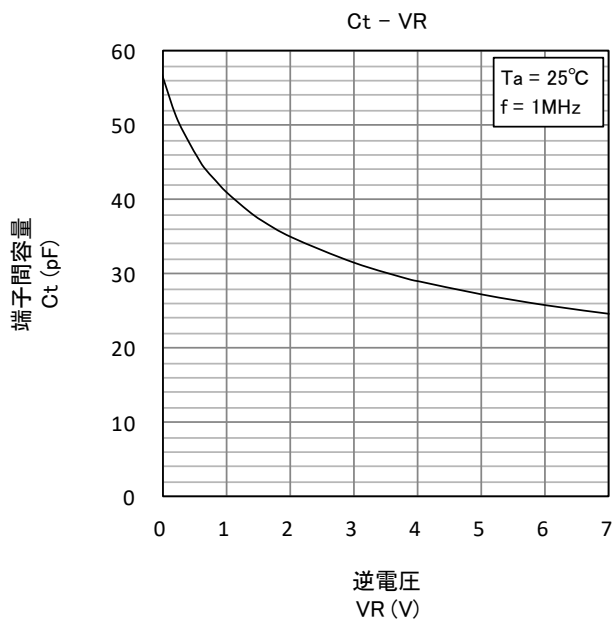
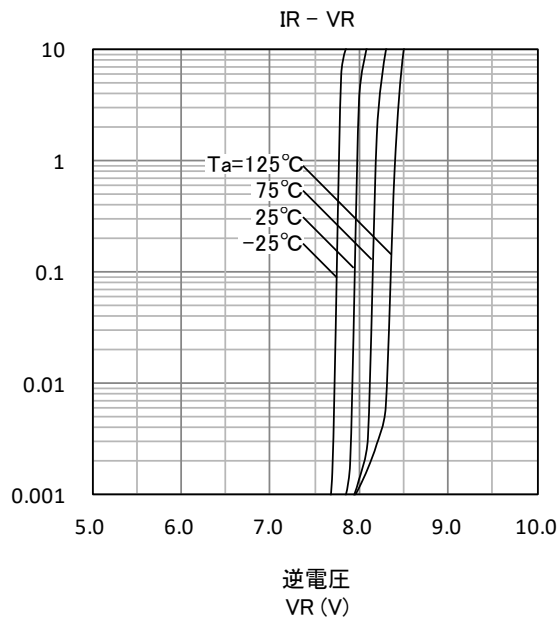
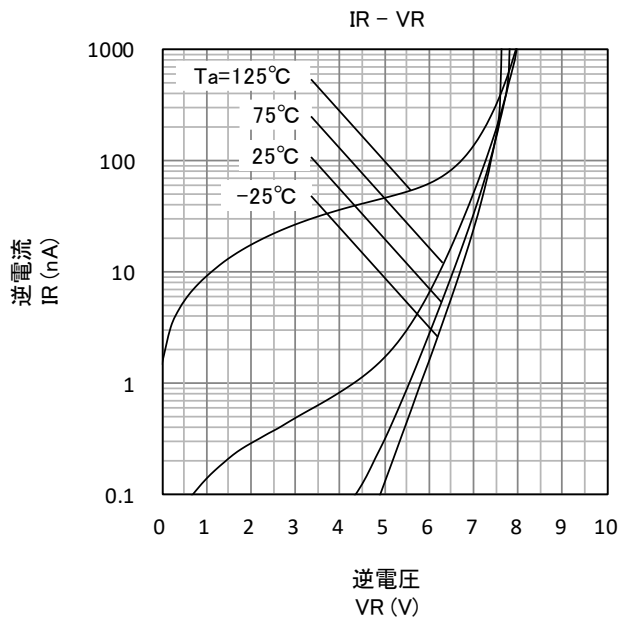
シリコン N チャンネル MOS 型電界効果トランジスタ
ツェナーダイオード
複合トランジスタ



RTE13K6M

シリコン N チャネル MOS 型電界効果トランジスタ
ツェナーダイオード
複合トランジスタ

標準特性(DIODE)



安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生する場合や誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たりましては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。